

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) **公開特許公報(A)**

(11) 特許出願公開番号

特開2006-39567

(P2006-39567A)

(43) 公開日 平成18年2月9日(2006.2.9)

(51) Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

G02F 1/1368 (2006.01)

G O 2 F 1/1368

2H090

GO2F 1/1337 (2006.01)

GO2F 1/1337

2H092

G02F 1/1343 (2006.01)

G O 2 F 1/1343

審査請求 未請求 請求項の数 17 O L (全 31 頁)

(21) 出願番号 特願2005-216211 (P2005-216211)

(22) 出願日 平成17年7月26日 (2005. 7. 26)

(31) 優先権主張番号 10-2004-0058709

(32) 優先日 平成16年7月27日 (2004. 7. 27)

(33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 390019839

三星電子株式会社

Samsung Electronics
Co., Ltd.

Co., Ltd

大韓民國京畿道水原市靈通區梅灘洞 416
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do, Republic of Korea

416, Maetan-dong, Yeo

ng tong-gu, Suwon-si

Gyeonggi-do, Republic of Korea

c o f K o r e a

(74) 代理人 100094145

弁理士 小野 由己男

(74) 代理人 100106367

弁理士 稻積 朋子

[最終頁に続く](#)

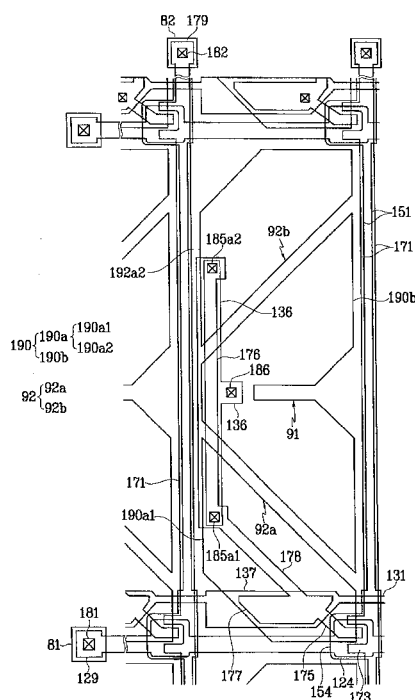
(54) 【発明の名称】 薄膜トランジスタ表示板

(57) 【要約】

【課題】 視認性に優れた多重ドメイン液晶表示装置を実現する。

【解決手段】 基板と、前記基板上に形成されている第1信号線と、前記第1信号線と交差している第2信号線と、前記第1信号線及び前記第2信号線と連結されている薄膜トランジスタと、互いに離れており、前記薄膜トランジスタと連結されている第1及び第2副画素電極と、前記第1及び第2副画素電極のうちの少なくとも一つと容量性結合している第3副画素電極を有する画素電極とを含む。

【選択図】 図 24



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、
前記基板上に形成されている第 1 信号線と、
前記第 1 信号線と交差している第 2 信号線と、
前記第 1 信号線及び前記第 2 信号線と連結されている薄膜トランジスタと、
互いに離れており、前記薄膜トランジスタと連結されている第 1 及び第 2 副画素電極と

、
前記第 1 及び第 2 副画素電極のうちの少なくとも一つと容量性結合している第 3 副画素電極を有する画素電極とを含む、薄膜トランジスタ表示板。

10

【請求項 2】

前記第 1 及び第 2 副画素電極は前記第 3 副画素電極を間に置いて両側に配置されている、請求項 1 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 3】

前記第 1 または第 2 副画素電極と電氣的に連結されており、前記第 2 副画素電極と容量性結合している容量電極をさらに含む、請求項 2 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 4】

前記第 1 副画素電極、前記第 2 副画素電極及び前記結合電極のうちの少なくとも一つと重畳する維持電極をさらに含む、請求項 3 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 5】

前記結合電極は前記第 3 副画素電極と重畳する、請求項 3 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

20

【請求項 6】

前記結合電極と前記画素電極との間に形成されており、前記結合電極と前記第 3 副画素電極との間に位置して他の部分より薄い部分を有する絶縁膜をさらに含む、請求項 5 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 7】

前記絶縁膜は無機膜及び有機膜を含む、請求項 6 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 8】

前記有機膜は前記結合電極上に位置する開口部を有し、前記結合電極と前記第 3 副画素電極は前記開口部内に位置する、請求項 7 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

30

【請求項 9】

前記第 3 副画素電極と連結されており、前記結合電極と重畳する容量電極をさらに含む、請求項 5 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 10】

前記第 1 信号線と前記第 2 信号線との間及び前記容量電極と前記結合電極との間に形成されている第 1 絶縁膜と、

前記第 2 信号線と前記画素電極との間及び前記結合電極と前記第 3 副画素電極との間に形成されている第 2 絶縁膜と、をさらに含む、請求項 9 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

40

【請求項 11】

前記第 3 副画素電極と連結されており、前記結合電極と重畳する容量電極をさらに含む、請求項 3 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 12】

前記第 1 信号線と前記第 2 信号線との間及び前記容量電極と前記結合電極との間に形成されている絶縁膜をさらに含む、請求項 11 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 13】

前記結合電極は前記薄膜トランジスタからのびる、請求項 3 に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項 14】

50

前記第3副画素電極と連結されており、前記第1または第2副画素電極と重畳する容量電極をさらに含む、請求項1に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項15】

前記第2信号線と前記画素電極との間に形成されている絶縁膜をさらに含む、請求項1に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項16】

前記絶縁膜は無機膜及びその上の有機膜を含む、請求項15に記載の薄膜トランジスタ表示板。

【請求項17】

前記画素電極を前記第1、第2、第3副画素電極に区画する区画部材をさらに含む、請求項1に記載の薄膜トランジスタ表示板。 10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は薄膜トランジスタ表示板に関し、特に、多重ドメイン液晶表示装置に用いられる薄膜トランジスタ表示板に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置は、一般に、液晶を挟み持つように組立てられる2枚の板状部材、即ち上部表示板と下部表示板を備えており、上部表示板には共通電極とカラーフィルターなどが形成され、下部表示板には薄膜トランジスタ及び画素電極などが形成されていて薄膜トランジスタ表示板と呼ばれることが多く、本願発明もこれに係るものである。液晶表示装置を概説すれば、上下表示板の間に液晶物質を注入しておき、画素電極と共通電極に互いに異なる電圧を印加することにより電界を形成し、電界形成状況に応じて、液晶分子の配列が変化し、これを通る光の透過率を調節することによって画像を実現する装置である。 20

【0003】

ところが、液晶表示装置は視野角の狭いことが重要な短所である。このような短所を克服しようと視野角を広げるための様々な方案が開発されている。その中でも液晶分子を上下表示板に対して垂直に配向させ、画素電極とその対向電極である共通電極に一定の切開（切欠き、または切り離し、ともいう）パターンまたは突起を形成する方法が有力視されている。 30

【0004】

切開パターンを利用する方法としては、画素電極と共通電極に各々切開パターンを形成させ、これら切開パターンによって、その輪郭部に形成されるフリンジフィールドを利用して液晶分子の傾斜方向を調節することによって視野角を広げる方法がある。

突起を利用する方法は、上下表示板に形成されている画素電極と共通電極上に、それぞれ突起を形成して置き、突起によって歪曲される電場を利用して液晶分子の傾斜方向を調節する方法である。

【0005】

他の方法としては、下部表示板上に形成されている画素電極には切開パターンを形成し、上部表示板に形成されている共通電極上には突起を形成し、切開パターンと突起によって形成されるフリンジフィールドを利用して液晶の傾斜方向を調節してドメインを形成する方法がある。 40

このような多重ドメイン液晶表示装置は、1:10のコントラスト比を基準にするコントラスト比基準視野角や階調間の輝度反転の限界角度で定義される階調反転基準視野角が全ての方向において80°以上で非常に優れている。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかし、正面のガンマ曲線と側面のガンマ曲線とが一致しない側面ガンマ曲線歪曲現象 50

が発生して左右側面における視認性劣化を示す。例えば、ドメイン分割手段である切開部を形成したPVAモード(patterned vertically aligned mode)の場合には、側面に向かうほど全体的に画面が明るく見えて、色は白くなる傾向がある。激しい場合には、明るい階調間の間隔差がなくなって絵が歪んで見える場合も発生する。ところが、最近、液晶表示装置をマルチメディア用として用いながら、絵を見たり動画を見ることが増加することによって視認性が益々重要視されている。

【0007】

本発明が目的とする技術的課題は、視認性に優れた多重ドメイン液晶表示装置を実現することである。

【課題を解決するための手段】

10

【0008】

このような課題を解決するために、本発明では画素電極を少なくとも二つ以上の副画素電極に分けて、副画素電極に互いに異なる電位が印加されるようにする。

本願第1発明の薄膜トランジスタ表示板は、基板と、前記基板上に形成されている第1信号線と、前記第1信号線と交差している第2信号線と、前記第1信号線及び前記第2信号線と連結されている薄膜トランジスタと、互いに離れており、前記薄膜トランジスタと連結されている第1及び第2副画素電極と、前記第1及び第2副画素電極のうちの少なくとも一つと容量性結合している第3副画素電極を有する画素電極とを含む。

【0009】

本発明によれば、画素電極を分割して互いに異なる電圧を印加をすることによって液晶表示装置の側面視認性を向上させ、これによって視野角を拡張することができる。具体的には、画素電極が分割されて互いに異なる電圧が印加されることで、それぞれの第1副画素と第2副画素における液晶分子の傾斜角度が異なるため、二つの副画素の輝度が異なる。したがって、側面から眺める映像を正面から眺める映像に最大限近くすることができ、これによって側面視認性を向上することができる。本願第2発明は、第1発明において、前記第1及び第2副画素電極は前記第3副画素電極を間に置いて両側に配置されていることができる。

20

【0010】

本願第3発明は、第2発明において、前記薄膜トランジスタ表示板は、前記第1または第2副画素電極と電氣的に連結されており、前記第2副画素電極と容量性結合している容量電極をさらに含むことができる。

30

本願第4発明は、第3発明において、前記薄膜トランジスタ表示板は、前記第1副画素電極、前記第2副画素電極及び前記結合電極のうちの少なくとも一つと重畳する維持電極をさらに含むことができる。このような維持電極をもうけることで、1副画素電極、前記第2副画素電極及び前記結合電極の電位を補償することができる。本願第5発明は、第3発明において、前記結合電極は前記第3副画素電極と重畳することができる。

【0011】

本願第6発明は、第5発明において、前記薄膜トランジスタ表示板は、前記結合電極と前記画素電極との間に形成されており、前記結合電極と前記第3副画素電極との間に位置して他の部分より薄い部分を有する絶縁膜をさらに含むことができる。結合電極と前記第3副画素電極との間の絶縁膜を薄くすることで、キャパシタの容量を維持することができる。

40

【0012】

本願第7発明は、第6発明において、前記絶縁膜は無機膜及び有機膜を含むことができる。無機膜により下部の膜との接触性を高め、有機膜により平坦性を確保し易くなる。

本願第8発明は、第7発明において、前記有機膜は前記結合電極上に位置する開口部を有し、前記結合電極と前記第3副画素電極は前記開口部内に位置することができる。このように形成されることで、画素の開口率の減少を防ぐことができる。

【0013】

本願第9発明は、第5発明において、前記薄膜トランジスタ表示板は、前記第3副画素

50

電極と連結されており、前記結合電極と重畳する容量電極をさらに含むことができる。

本願第 10 発明は、第 9 発明において、前記薄膜トランジスタ表示板は、前記第 1 信号線と前記第 2 信号線との間及び前記容量電極と前記結合電極との間に形成されている第 1 絶縁膜と、前記第 2 信号線と前記画素電極との間及び前記結合電極と前記第 3 副画素電極との間に形成されている第 2 絶縁膜とをさらに含むことができる。

【0014】

本願第 11 発明は、第 3 発明において、前記第 3 副画素電極と連結されており、前記結合電極と重畳する容量電極をさらに含む薄膜トランジスタ表示板を提供する。

本願第 12 発明は、第 11 発明において、前記第 1 信号線と前記第 2 信号線との間及び前記容量電極と前記結合電極との間に形成されている絶縁膜をさらに含む薄膜トランジスタ表示板を提供する。 10

【0015】

本願第 13 発明は、第 3 発明において、前記結合電極は前記薄膜トランジスタからのびることができる。

本願第 14 発明は、第 1 発明において、前記薄膜トランジスタは、前記第 3 副画素電極と連結されており、前記第 1 または第 2 副画素電極と重畳する容量電極をさらに含むことができる。本願第 15 発明は、第 1 発明において、前記第 2 信号線と前記画素電極との間に形成されている絶縁膜をさらに含む薄膜トランジスタ表示板を提供する。

【0016】

本願第 16 発明は、第 15 発明において、前記絶縁膜は無機膜及びその上の有機膜を含む薄膜トランジスタ表示板を提供する。 20

本願第 17 発明は、第 1 発明において、前記薄膜トランジスタ表示板は、前記画素電極を前記第 1、第 2、第 3 副画素電極に区画する区画部材をさらに含むことができる。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、視認性に優れた多重ドメイン液晶表示装置を実現することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

添付した図面を参考にして、本発明の実施形態に対して本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な異なる形態で実現でき、ここで説明する実施形態に限定されない。 30

図面では各種の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明細書全体を通して類似した部分については同一な図面符号を付けた。層、膜、領域、板などの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合だけでなく、その中間に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上に”あるとする時には、中間に他の部分がないことを意味する。

【0019】

以上を前提とし、図面を参考にして本発明の実施形態による液晶表示装置及びこれに用いられる薄膜トランジスタ表示板の構造について説明する。

図 1 は本発明の一実施形態による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図である。図 2 は本発明の一実施形態による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図である。図 3 は本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。図 4 は図 3 の液晶表示装置を I V - I V ' 線に沿って切断した断面図である。図 5 は図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置の等価回路図である。 40

【0020】

図 1 乃至図 4 によると、本実施形態による液晶表示装置は、下側の薄膜トランジスタ表示板 100、これと対向している上側の対向表示板 200 及びこれらの間に形成されている液晶層 3 からなる。

まず、薄膜トランジスタ表示板 100 について詳細に説明する。

透明なガラスまたはプラスチックなどで作られた絶縁基板 110 上に複数のゲート線 1 50

2 1、複数の維持電極線 1 3 1 及び複数の容量電極 1 3 6 を含む複数のゲート導電体が形成されている。

【0 0 2 1】

ゲート線 1 2 1 は主に図中横方向にのびており、各ゲート線 1 2 1 の一部は複数のゲート電極 1 2 4 を成す。ゲート線 1 2 1 にはゲート電極 1 2 4 が直線のゲート線 1 2 1 から突出するように突起の形態で形成されており、本実施形態のようにゲート線 1 2 1 は外部からのゲート信号をゲート線 1 2 1 に伝達するための接触部を有することができる。この時、ゲート線 1 2 1 の端部 1 2 9 は他の部分より広い幅は有する。ゲート駆動回路は基板 1 1 0 の上部に直接形成されることができて、ゲート線 1 2 1 の端部はゲート駆動回路の出力端に連結される。

10

【0 0 2 2】

ゲート線 1 2 1 と同一層には、維持電極線 1 3 1 が横方向にのびて形成されており、それぞれの維持電極線 1 3 1 は他の部分より広い幅を有する維持電極 1 3 7 を含む。この時、維持電極線 1 3 1 は画素の開口率を確保するために画素の縁に配置するのが好ましい。

容量電極 1 3 6 は、ゲート線 1 2 1 及び維持電極線 1 3 1 と分離されており、図中上方に突出した突出部 1 3 9 を含む広い横部とこれに連結された狭い縦部を有する。横部はゲート線 1 2 1 とほぼ平行にのびる長方形であって、隣接した二つのゲート線 1 2 1 とほぼ同一の距離を置いている。縦部は横部の右端から維持電極線 1 3 1 に向かってのびている。

【0 0 2 3】

20

ゲート導電体 1 2 1、1 3 1、1 3 6 は、Al、Al 合金、Ag、Ag 合金、Cr、Ti、Ta、Mo などまたはこれらを含む合金の金属などで作られる。本実施形態のゲート線 1 2 1 及び維持電極線 1 3 1 は単一層で構成するが、物理化学的特性に優れた Cr、Mo、Ti、Ta などを含む金属層と、比抵抗の小さい Al 系列または Ag 系列の金属層とを含む二重層で構成してもよい。その他にも、多様な金属または導電体でゲート導電体 1 2 1、1 3 1、1 3 6 を作ることができる。

【0 0 2 4】

ゲート導電体 1 2 1、1 3 1、1 3 6 の側面は傾いており、水平面に対する傾斜角は 30° ~ 80° であるのが好ましい。

ゲート導電体 1 2 1、1 3 1、1 3 6 の上には、窒化ケイ素 (SiNx) などからなるゲート絶縁膜 1 4 0 が形成されている。

30

ゲート絶縁膜 1 4 0 上には水素化非晶質シリコン (非晶質シリコンは略称 a-Si という) または多結晶シリコンなどで作られた複数の線状半導体 1 5 1 が形成されている。線状半導体 1 5 1 は主に図中縦方向にのびており、ゲート電極 1 2 4 に向かってのび出した複数の突出部 1 5 4 を含む。線状半導体 1 5 1 はゲート線 1 2 1 及び維持電極線 1 3 1 の付近で幅が広がってこれらを幅広く覆っている。

【0 0 2 5】

半導体 1 5 1 上には複数の線状及び島状抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 が形成されている。抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 はリンなどの n 型不純物が高濃度にドーピングされている n + 水素化非晶質シリコンなどの物質で作られるか、シリサイドで作られることができる。線状抵抗性接触部材 1 6 1 は複数の突出部 1 6 3 を有しており、この突出部 1 6 3 と島状抵抗性接触部材 1 6 5 は対をなして半導体 1 5 1 の突出部 1 5 4 上に配置されている。

40

【0 0 2 6】

抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 及びゲート絶縁膜 1 4 0 上には、複数のデータ線 1 7 1 及び複数のドレイン電極 1 7 5 を含む複数のデータ導電体が形成されている。

各データ線 1 7 1 は主に縦方向にのびており、各ドレイン電極 1 7 5 に向かって複数の分岐を出してデータ線 1 7 1 から拡張されたソース電極 1 7 3 を有する。データ線 1 7 1 の一端部分に位置した接触部 1 7 9 は、外部からの画像信号をデータ線 1 7 1 に伝達する。

50

【0027】

ドレイン電極175はデータ線171と分離されており、ゲート電極124を間に置いてソース電極173と対向する棒状端部を含む。棒状端部はその一部が曲がったソース電極173で囲まれている。

各ドレイン電極175は、また拡張部177及びこれと連結された結合電極176を含む。

【0028】

結合電極176は容量電極136と重畳し、容量電極136とほぼ同一な形状である。つまり、結合電極176も広い横部及び横部と拡張部177に連結されている縦部を含む。しかし、結合電極176は容量電極136の突出部139とは重畳しない。

10

一つのゲート電極124、一つのソース電極173及び一つのドレイン電極175は半導体151の突出部154と共に、一つの薄膜トランジスタ(TFT)を構成し、薄膜トランジスタのチャンネルはソース電極173とドレイン電極175の間の突出部154に形成される。

【0029】

データ導電体171、175もゲート線121と同様に、モリブデン、クロム及びアルミニウムなどの物質またはこれらを含む合金で作られ、単一層または多重層で構成することができる。

データ導電体171、175もまたその側面が基板110面に対して30°~80°程度の傾斜角で傾くのが好ましい。

20

【0030】

抵抗性接触部材161、165はその下の半導体151とその上のデータ導電体171、175との間にだけ存在し、これらの間の接触抵抗を低くする。大部分の所では線状半導体151がデータ線より狭いが、前述したように、ゲート線121と合う部分で幅が広がって表面のプロファイルをスムーズにすることによってデータ線171が断線することを防止する。半導体151にはソース電極173とドレイン電極175との間をはじめ、データ導電体171、175で覆われず露出された部分がある。

【0031】

データ線171及びドレイン電極175上には、平坦化特性に優れて感光性を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着(PECVD)で形成されるa-Si:C:O、a-Si:O:Fなどの低誘電率絶縁物質または窒化ケイ素などからなる保護膜180が形成されている。この時、保護膜180は窒化ケイ素または酸化ケイ素からなる第1絶縁膜180pと、有機絶縁物質からなる第2絶縁膜180qとを含む。薄膜トランジスタ表示板100の上部に赤、緑、青色のカラーフィルター230を形成する他の実施形態では、第2絶縁膜180qは赤、緑、青色のカラーフィルター230に替えることができる。

30

【0032】

保護膜180にはデータ線171の端部179及びドレイン電極175の拡張部177を各々露出させる複数の接触孔182、185が備えられており、ゲート線121の端部129の一部を露出する複数の接触孔181及び容量電極136の突出部139を露出する複数の接触孔186がゲート絶縁膜140と保護膜180を貫通している。接触孔181、182、185、186は傾いているか、階段状の側壁を有することができて、これは有機物を使用することによって容易に得られる。

40

【0033】

保護膜180上には複数の画素電極をはじめ、複数の接触補助部材81、82が形成されている。画素電極及び接触補助部材81、82はITO(インジウム錫酸化物)やIZO(インジウム亜鉛酸化物)などのような透明導電体やアルミニウム(Al)のような光反射特性に優れた不透明導電体などで作られる。

各画素電極190は四つの角が面取りされているほぼ四角形状であり、面取りされた斜辺はゲート線121に対して約45°の角度を構成する。

【0034】

50

各画素電極 190 は間隙 92 を間に置いて分れた外側及び内側副画素電極 190 a、190 b を含む。

間隙 92 は下部分 92 a 及び上部分 92 b、そしてこれらを連結する縦部 92 c を含む。間隙 92 の下部分及び上部分 92 a、92 b はほぼ画素電極 190 の右辺から左辺へのびており、ゲート線 121 に対して各々時計方向及び反時計方向に約 45° の角度を構成する。間隙 92 の縦部 92 c は下部分及び上部分 92 a、92 b の左端を連結する。

【0035】

その結果、内側副画素電極 190 b はほぼ直角だけ回転した二等辺梯形になり、外側副画素電極 190 a はほぼ直角だけ回転した一对の直角梯形とこれを連結する縦連結部を含む。

外側副画素電極 190 a は接触孔 185 を通じてドレイン電極 175 の拡張部 177 と連結されている。

【0036】

内側副画素電極 190 b は接触孔 186 を通じて容量電極 136 と連結されており、結合電極 176 と一部重畳する。内側副画素電極 190 b と容量電極 136 は結合電極 176 と共に“結合キャパシタ”を構成する。

内側副画素電極 190 b には切開部 91 が形成されている。切開部 91 は画素電極 190 の横中心線に沿ってのびて、右辺方向に入口を有している。切開部 91 の入口は間隙 92 の下部分 92 a 及び上部分 92 b に各々ほぼ平行な一对の斜辺を有している。

【0037】

切開部 91 及び間隙 92 a、92 b (今後、間隙も切開部という) を含む画素電極 190 は容量電極 136 に対してほぼ反転対称をなし、今後間隙 92 の各部分 92 a ~ 92 c を個別的に切開部ともいう。

この時、切開部の数または領域の数は画素電極 190 の大きさ、画素電極 190 の横辺と縦辺との長さ比、液晶層 3 の種類や特性など設計要素によって変わることがある。

【0038】

接触補助部材 81、82 は各々接触孔 181、182 によってゲート線 121 の端部 129 とデータ線 171 の端部 179 に連結されている。

次に、共通電極表示板 200 について図 2 乃至図 4 を参照して詳細に説明する。

絶縁基板 210 には光が漏れることを防止するためのブラックマトリックス 220 ともいう遮光部材 220 が形成されている。遮光部材 220 には画素電極 190 と対向して画素電極 190 とほぼ同一な形状を有する複数の開口部 225 が形成されている。これと違って、遮光部材 220 は薄膜トランジスタ表示板 100 のデータ線 171 に対応する線形部及び薄膜トランジスタに対応する面形部を含むことができる。

【0039】

遮光部材 220 上には、赤、緑、青色の三原色のカラーフィルター 230 が形成されている。遮光部材 220 及びカラーフィルター 230 の上には、蓋膜 250 が形成されている。蓋膜 250 は (有機) 絶縁物で作られることができ、カラーフィルター 230 を保護してカラーフィルター 230 が露出されることを防止し、平坦面を提供する。

蓋膜 250 上には複数組みの切開部 71、72 a、72 b を有する共通電極 270 が形成されている。共通電極 270 は ITO または IZO などの透明な導電体で形成する。

【0040】

一つの切開部 71 - 72 b 集合は一つの画素電極 190 と対向して中央切開部 71、下部切開部 72 a 及び上部切開部 72 b を含む。切開部 71 - 72 b 各々は画素電極 190 の隣接切開部 91 - 92 b との間、または切開部 92 a、92 b と画素電極 190 の面取りした斜辺との間に配置されている。また、各切開部 71 - 72 b は画素電極 190 の下部切開部 92 a または上部切開部 92 b と平行にのびた少なくとも一つの斜線部を含み、各斜線部には陥没した少なくとも一つの切欠 (notch) がある。切開部 71 - 72 b は容量電極 136 に対してほとんど反転対称をなす。

【0041】

10

20

30

40

50

下部及び上部切開部 7 2 a、7 2 b 各々は斜線部と横部及び縦部を含む。斜線部はほぼ画素電極 1 9 0 の上辺または下辺から左辺へのびる。横部及び縦部は斜線部の各端から画素電極 1 9 0 の辺に沿って辺と重畳しながらのびて斜線部と鈍角をなす。

中央切開部 7 1 は中央横部、一对の斜線部及び一对の縦断縦部を含む。中央横部はほぼ画素電極 1 9 0 の左辺から画素電極 1 9 0 の横中心線に沿って右側へのびて、一对の斜線部は中央横部の端から画素電極 1 9 0 の右辺に向かって各々下部及び上部切開部 7 2 a、7 2 b とほとんど並んでのびる。縦断縦部は当該斜線部の端から画素電極 1 9 0 の右辺に沿って右辺と重畳しながらのびて斜線部と鈍角をなす。

【0042】

切開部 7 1 - 7 2 b の数もまた設計要素によって変わることがあり、遮光部材 2 2 0 が切開部 7 1 - 7 2 b と重畳して切開部 7 1 - 7 2 b 付近の光漏れを遮断することができる。 10

表示板 1 0 0、2 0 0 の内側面には配向膜 1 1、2 1 が塗布されており、これらは垂直配向膜であり得る。表示板 1 0 0、2 0 0 の外側面には偏光子 1 2、2 2 が備えられているが、二つの偏光子 1 2、2 2 の偏光軸は直交し、この中で一つの偏光軸はゲート線 1 2 1 に対して並んだのが好ましい。反射型液晶表示装置の場合には二つの偏光子 1 2、2 2 のうちの一つが省略できる。

【0043】

本実施形態による液晶表示装置は液晶層 3 の遅延値を補償するための位相遅延膜（図示せず）をさらに含むことができる。位相遅延膜は複屈折性を有し、液晶層 3 の位相遅延を逆に補償する。 20

液晶表示装置は偏光子 1 2、2 2、位相遅延膜、表示板 1 0 0、2 0 0 及び液晶層 3 に光を供給する照明部（図示せず）を含むことができる。

【0044】

液晶層 3 は陰の誘電率異方性を有し、液晶層 3 の液晶分子は電場のない状態でその長軸が二つの表示板の表面に対して垂直をなすように配向されている。したがって、入射光は直交偏光子 1 2、2 2 を通過できず遮断される。

このような液晶表示装置は図 5 の等価回路で表現することができる。

図 5 を参考にすれば、液晶表示装置の一つの画素は薄膜トランジスタ (Q)、第 1 液晶キャパシタ (C_{LCa}) 及びストレージキャパシタ (C_{ST}) を含む第 1 副画素、第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) を含む第 2 副画素、そして結合キャパシタ (C_{cp}) を含む。 30

【0045】

第 1 液晶キャパシタ (C_{LCa}) は一つの端子として外側副画素電極 1 9 0 a を含み、他の一つの端子として共通電極 2 7 0 の当該部分を含み、二つの端子の間の液晶層 3 部分を誘電体として含む。これと同様に、第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) は一つの端子として内側副画素電極 1 9 0 b を含み、他の一つの端子として共通電極 2 7 0 の当該部分を含み、二つの端子の間の液晶層 3 部分を誘電体として含む。

【0046】

ストレージキャパシタ (C_{ST}) は一つの端子としてドレイン電極 1 7 5 の拡張部 1 7 7 を含み、他の一つの端子として維持電極 1 3 7 を含み、二つの端子の間のゲート絶縁膜 1 4 0 部分を誘電体として含む。 40

結合キャパシタ (C_{cp}) は一つの端子として内側副画素電極 1 9 0 b と容量電極 1 3 6 を含み、他の一つの端子として結合電極 1 7 6 を含み、二つの端子の間の保護膜 1 8 0 及びゲート絶縁膜 1 4 0 部分を誘電体として含む。

【0047】

第 1 液晶キャパシタ (C_{LCa}) とストレージキャパシタ (C_{ST}) は薄膜トランジスタ (Q) のドレインに連結されており、結合キャパシタ (C_{cp}) は薄膜トランジスタ (Q) と第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) との間に連結されている。共通電極 2 7 0 には共通電圧 (V_{com}) が印加され、維持電極線 1 3 1 にも共通電圧 (V_{com}) が印加できる。

薄膜トランジスタ (Q) はゲート線 1 2 1 からのゲート信号によってデータ線 1 7 1 からのデータ電圧を第 1 液晶キャパシタ (C_{LCa}) 及び結合キャパシタ (C_{cp}) に印加し、結 50

合キャパシタ (C_{cp}) はこの電圧をその大きさを変えて第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) に伝達する。

【0048】

維持電極線 131 に共通電圧 (V_{com}) が印加されてキャパシタ (C_{Lca} 、 C_{ST} 、 C_{LCb} 、 C_{cp}) とその静電容量を同じ図面符号で示すとしたら、第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) に充電された電圧 (V_a) と第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) に充電された電圧 (V_b) は次のような関係を有する。

$$V_b = V_a \times [C_{cp} / (C_{cp} + C_{LCb})] \dots (\text{数 } 1)$$

10

$C_{cp} / (C_{cp} + C_{LCb})$ の値が 1 より小さいため、第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) に充電された電圧 (V_b) は第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) に充電された電圧 (V_a) に比べて常に小さい。この関係は維持電極線 131 の電圧が共通電圧 (V_{com}) ではなくても同様に成立する。

【0049】

このように、第 1 または第 2 液晶キャパシタ (C_{Lca} 、 C_{LCb}) の両端に電位差が発生すれば表示板 100、200 の面に対してほぼ垂直の電場が液晶層 3 に生成される (今後、画素電極 190 及び共通電極 270 を合わせて“電場生成電極”という)。では、液晶層 3 の液晶分子は電場に応答してその長軸が電場の方向に垂直をなすように傾き、液晶分子が傾斜した程度によって液晶層 3 に入射された光の偏光の変化程度が変わる。このような偏光の変化は偏光子 12、22 によって透過率変化として現れ、これを通じて液晶表示装置

20

【0050】

液晶分子の傾斜角度は電場の強さによって変わるが、第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) の電圧 (V_a) と第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) の電圧 (V_b) が互いに異なるので、第 1 副画素と第 2 副画素における液晶分子の傾斜角度が異なり、その結果、二つの副画素の輝度が異なる。したがって、第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) の電圧 (V_a) と第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) の電圧 (V_b) を適切に合せば、側面から眺める映像を正面から眺める映像に最大限近くすることができ、これによって側面視認性を向上することができる。

【0051】

第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) の電圧 (V_a) と第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) の電圧 (V_b) との比率は、結合キャパシタ (C_{cp}) の静電容量を変化させることによって調整することができ、結合キャパシタ (C_{cp}) の静電容量は第 2 副画素電極 190b 及び容量電極 136 と結合電極 176 との重畳面積と距離を調整することによって変えることができる。例えば、容量電極 136 をなくして結合電極 176 をそこに配置すれば、結合電極 176 と第 2 画素電極 190b との間の距離を遠くすることができる。第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) の電圧 (V_b) は第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) の電圧 (V_a) の 0.6 ~ 0.8 倍であるのが好ましい。

30

【0052】

これと違って、第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) の電圧 (V_b) を第 1 液晶キャパシタ (C_{Lca}) の電圧 (V_a) より高めることもできるが、これは第 2 液晶キャパシタ (C_{LCb}) を共通電圧などのような所定の電圧で予め充電することによって可能である。

40

第 1 副画素の下部及び上部画素電極 190a1、190a2 と第 2 副画素の中央画素電極 190b との面積比は 1 : 0.85 ~ 1 : 1.15 の範囲であるのが好ましく、各副画素の副画素電極の数は変わることがある。

【0053】

液晶分子の傾斜方向は電場生成電極 190、270 の切開部 91-92b、71-72b 及び画素電極 190 の斜辺が電場を歪曲して作りだす水平成分によって決定される。このような電場の水平成分は切開部 91-92b、71-72b の辺と画素電極 190 の辺に垂直である。図 3 を参考にすれば、一つの切開部集合 91-92b、71-72b は画素電極 190 を各々二つの傾斜した主辺を有する複数の副領域に分ける。各副領域上の液晶分子は主辺

50

に対して垂直方向に傾くので、傾斜方向を絞って見ると、大略四つの方向となる。このように液晶分子の傾斜方向を多様にすれば、液晶表示装置の基準視野角が大きくなる。

【0054】

また、四つの傾斜方向に対して光が通過できる領域の大きさを同一にすれば、多様な視野角で均一な視認性を得ることができる。前述したように、不透明な部材が上下対称に配列されているので、透過領域の大きさを調節しやすい。

切開部 71-72b の切欠は切開部 71-72b 上の液晶分子 310 の傾斜方向を決定し、切開部 91-92b にも形成されることができて、多様な形状及び配置を有することができる。

【0055】

液晶分子の傾斜方向を決定するための切開部 91-92b、71-72b の形状及び配置は変わることができ、少なくとも一つの切開部 91-92b、71-72b は突起（図示せず）や陥没部（図示せず）に代替することができる。突起は有機物または無機物で作られることができて、電場生成電極 190、270 の上または下に配置される。

次に、本発明の他の実施形態による液晶表示装置について図 6 及び図 7 を参照して説明する。

【0056】

図 6 は本発明の他の実施形態による液晶表示装置の構造を示した配置図であり、図 7 は図 6 の液晶表示装置を V I I - V I I ' 線に沿って切断した断面図である。

図 6 及び図 7 のように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板 100、共通電極表示板 200、二つの表示板 100、200 の間に入っている液晶層 3、そして表示板 100、200 の外側面に付着されている一対の偏光子 12、22 を含む。

【0057】

本実施形態による表示板の層状構造は、大抵図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置の層状構造と同一である。

薄膜トランジスタ表示板 100 を見れば、基板 110 上にゲート電極 124 と端部 129 を含む複数のゲート線 121、維持電極 137 を含む複数の維持電極線 131 及び複数の容量電極 136 が形成されており、その上にゲート絶縁膜 140、突出部 154 を含む複数の線状半導体 151、突出部 163 を各々含む複数の線状抵抗性接触部材 161 及び複数の島状抵抗性接触部材 165 が順次に形成されている。抵抗性接触部材 161、165 上にはソース電極 173 と端部 179 を含む複数のデータ線 171、拡張部 177 と結合電極 176 を含む複数のドレイン電極 175 が形成されており、その上に第 1 絶縁膜 180p と第 2 絶縁膜 180q を含む保護膜 180 が形成されている。保護膜 180 及び/またはゲート絶縁膜 140 には複数の接触孔 181、182、185、186 が形成されている。保護膜 180 上には副画素電極 190a、190b を含んで切開部 91-92b を有する複数の画素電極 190 と複数の接触補助部材 81、82 が形成されており、その上には配向膜が形成されている。

【0058】

共通電極表示板 200 について説明すれば、絶縁基板 210 上に遮光部材 220、複数のカラーフィルター、蓋膜 250、切開部 71-72b を有する共通電極、そして配向膜 21 が形成されている。

しかし、図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置と違い、本実施形態による薄膜トランジスタ表示板において、半導体 151 はデータ線 171、ドレイン電極 175 及びその下部の抵抗性接触部材 161、165 と実質的に同一な平面形態を有している。しかし、線状半導体 151 はソース電極 173 とドレイン電極 175 との間などデータ線 171 及びドレイン電極 175 で覆われず露出された部分を有している。

【0059】

このような薄膜トランジスタ表示板 100 を本発明の一実施形態によって製造する方法では、データ線 171 及びドレイン電極 175 と半導体 151 及び抵抗性接触部材 161

10

20

30

40

50

、 165 を一回の写真工程で形成する。

このような写真工程で使用する感光膜は、位置によって厚さが異なり、特に厚さが薄くなる順序に第1部分と第2部分を含む。第1部分はデータ線171、ドレイン電極175及び金属片178が占める配線領域に位置し、第2部分は薄膜トランジスタのチャンネル領域に位置する。

【0060】

位置によって感光膜の厚さを異なるようにする方法として多様な方法があるが、例えば、光マスクに投光領域及び遮光領域の他に半透明領域を設ける方法がある。半透明領域にはスリットパターン、格子パターンまたは透過率が中間であるか厚さが中間である薄膜が備えられる。スリットパターンを使用する時には、スリットの幅やスリットの間の間隔が写真工程で使用する露光器の分解能より小さいのが好ましい。他の例としてはリフローが可能な感光膜を使用する方法がある。つまり、投光領域及び遮光領域だけを有する通常の露光マスクでリフロー可能な感光膜を形成した後、リフローさせて感光膜が残留しない領域へ流れるようにすることによって薄い部分を形成する方法である。

10

【0061】

このようにすれば、一回の写真工程を減らすことができるので製造方法が簡単になる。

図1乃至図4に示す液晶表示装置の多くの特徴が図6及び図7に示す液晶表示装置にも適用できる。

本発明の他の実施形態による液晶表示装置について図8を参照して詳細に説明する。

図8は本発明の他の実施形態による液晶表示装置の配置図である。

20

【0062】

本実施形態による液晶表示装置の層状構造は図1乃至図4に示すものと同一であり、図1乃至図4に示すものと同じ図面符号を使用して説明する。

図8に示すように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板100、共通電極表示板200、二つの表示板100、200の間に入っている液晶層3、そして表示板100、200の外側面に付着されている一对の偏光子12、22を含む。

【0063】

薄膜トランジスタ表示板100を見れば、基板110上にゲート電極124と端部129を含む複数のゲート線121、維持電極137を含む複数の維持電極線131及び複数の容量電極136が形成されており、その上にゲート絶縁膜140、突出部154を含む複数の線状半導体151、突出部163を各々含む複数の線状抵抗性接触部材161及び複数の島状抵抗性接触部材165が順次に形成されている。抵抗性接触部材161、165及びゲート絶縁膜140上にはソース電極173と端部179を含む複数のデータ線171、拡張部177と結合電極176を含む複数のドレイン電極175が形成されており、その上に第1絶縁膜180pと第2絶縁膜180qを含む保護膜180が形成されている。保護膜180及び/またはゲート絶縁膜140には複数の接触孔181、182、185、186が形成されている。保護膜180上には副画素電極190a、190bを含んで切開部91-92を有する複数の画素電極190と複数の接触補助部材81、82が形成されており、その上には配向膜11が形成されている。

30

【0064】

共通電極表示板200について説明すれば、絶縁基板210上に遮光部材220、複数のカラーフィルター230、蓋膜250、切開部71-72bを有する共通電極、そして配向膜21が形成されている。

40

しかし、図1乃至図4に示す液晶表示装置と違って、結合電極176各々はドレイン電極175の拡張部177から上へのびて共通電極270の中央切開部71と合った後、方向を変えて中央切開部71に沿ってのびる。容量電極136は結合電極176と同一な平面形状を有するか、副画素電極190bとの接続のための突出部139を有している。

【0065】

このような構造において、結合電極176と結合電極136は、切開部71を通して漏洩する光を遮断する機能を有し、電極176、136が占める透明領域の無駄な部分を減

50

らすことによって開口率を高める。

図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置の多くの特徴が図 8 に示す液晶表示装置にも適用できる。

【0066】

本発明の他の実施形態による液晶表示装置について図 9、図 10 及び図 11 を参照して詳細に説明する。

図 9 は本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、図 10 は本発明の他の実施形態による共通電極の配置図であり、図 11 は図 9 及び図 10 の二つの表示板を含む液晶表示装置の配置図である。

【0067】

本実施形態による液晶表示装置の層状構造は図 1 乃至図 4 に示すものと同一であり、図 1 乃至図 4 に示すものと同じ図面符号を使用して説明する。

図 9 乃至図 11 に示すように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板 100、共通電極表示板 200、二つの表示板 100、200 の間に入っている液晶層 3、そして表示板 100、200 の外側面に付着されている一対の偏光子 12、22 を含む。

【0068】

薄膜トランジスタ表示板 100 を見れば、基板 110 上にゲート電極 124 と端部 129 を含む複数のゲート線 121、維持電極 137 を含む複数の維持電極線 131 及び複数の容量電極 136 が形成されており、その上にゲート絶縁膜 140、突出部 154 を含む複数の線状半導体 151、突出部 163 を各々含む複数の線状抵抗性接触部材 161 及び複数の島状抵抗性接触部材 165 が順次に形成されている。抵抗性接触部材 161、165 及びゲート絶縁膜 140 上にはソース電極 173 と端部 179 を含む複数のデータ線 171、拡張部 177 と結合電極 176 を含む複数のドレイン電極 175 が形成されており、その上に第 1 絶縁膜 180p と第 2 絶縁膜 180q を含む保護膜 180 が形成されている。保護膜 180 及びゲート絶縁膜 140 には複数の接触孔 181、182、185、186 が形成されている。保護膜 180 上には副画素電極 190a、190b を含んで切開部 93-96b を有する複数の画素電極 190 と複数の接触補助部材 81、82 が形成されており、その上には配向膜 11 が形成されている。

【0069】

共通電極表示板 200 について説明すれば、絶縁基板 210 上に遮光部材 220、複数のカラーフィルタ 230、蓋膜 250、切開部 73-76b を有する共通電極、そして配向膜 21 が形成されている。

しかし、図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置と違って、画素電極 190 は五つの切開部 93、94、95、96a、96b を有する。切開部 95 は画素電極 190 を副画素電極 190a、190b に分ける間隙であって、副画素電極 190b にある切開部 93 は容量電極 136 の横部に沿ってのびて、画素電極 190 の右辺に入口を有している。副画素電極 190b にある切開部 94 は容量電極 136 の横部に沿ってのびた短い横部と、横部から画素電極 190 の右辺に向かってななめにのびた一対の斜線部とを含む。副画素電極 190a の切開部 96a、96b 各々は、ほぼ画素電極 190 の下辺または上辺から出発して画素電極 190 の左辺に向かってななめにのびる。切開部 93-96b の斜線部または辺はゲート線 121 と約 45° の角度を構成する。

【0070】

これに対応して共通電極 270 の切開部集合の一つは、六つの切開部 73、74、75a、75b、76a、76b を有する。切開部 73、74 各々は中央横部、一対の斜線部及び縦断縦部を含む。切開部 75a-76b は斜線部、一対の横部及び縦部、または一つの縦部及び拡張部を含む。切開部 73-76b の斜線部は切開部 93-96b の斜線部と並んでのびる。

【0071】

図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置の多くの特徴が図 9 乃至図 11 に示す液晶表示装置に

10

20

30

40

50

も適用できる。

本発明の他の実施形態による液晶表示装置について図 1 2、図 1 3、図 1 4 及び図 1 5 を参照して詳細に説明する。

図 1 2 は本発明の他の実施形態による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、図 1 3 は本発明の他の実施形態による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図であり、図 1 4 は図 1 2 の薄膜トランジスタ表示板と図 1 3 の共通電極表示板を含む液晶表示装置の配置図であり、図 1 5 は図 1 4 の液晶表示装置を X V - X V ' 線に沿って切断した断面図である。

【0072】

図 1 2 乃至図 1 5 に示すように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板 1 0 0、共通電極表示板 2 0 0、二つの表示板 1 0 0、2 0 0 の間に入っている液晶層 3、そして表示板 1 0 0、2 0 0 の外側面に付着されている一対の偏光子 1 2、2 2 を含む。

大部分の薄膜トランジスタ表示板 1 0 0 と共通電極表示板 2 0 0 の層状構造は図 1 乃至図 4 と同一である。

【0073】

薄膜トランジスタ表示板 1 0 0 を見れば、基板 1 1 0 上にゲート電極 1 2 4 と端部 1 2 9 を含む複数のゲート線 1 2 1 及び維持電極 1 3 7 を含む複数の維持電極線 1 3 1 が形成されており、その上にゲート絶縁膜 1 4 0、突出部 1 5 4 を含む複数の線状半導体 1 5 1、突出部 1 6 3 を各々含む複数の線状抵抗性接触部材 1 6 1 及び複数の島状抵抗性接触部材 1 6 5 が順次に形成されている。抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 及びゲート絶縁膜 1 4 0 上にはソース電極 1 7 3 と端部 1 7 9 を含む複数のデータ線 1 7 1 及び複数のドレイン電極 1 7 5 が形成されており、その上に第 1 絶縁膜 1 8 0 p と第 2 絶縁膜 1 8 0 q を含む保護膜 1 8 0 が形成されている。保護膜 1 8 0 及びゲート絶縁膜 1 4 0 には複数の接触孔 1 8 1、1 8 2、1 8 5 が形成されている。保護膜 1 8 0 上には副画素電極 1 9 0 a、1 9 0 b を含んで切開部 9 1 - 9 2 b を有する複数の画素電極 1 9 0 と複数の接触補助部材 8 1、8 2 が形成されており、その上には配向膜 1 1 が形成されている。

【0074】

共通電極表示板 2 0 0 について説明すれば、絶縁基板 2 1 0 上に遮光部材 2 2 0、複数のカラーフィルター 2 3 0、蓋膜 2 5 0、切開部 7 1 - 7 2 b を有する共通電極、そして配向膜 2 1 が形成されている。

しかし、図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置と違って、容量電極がない。

維持電極線 1 3 1 は隣接した二つのゲート線 1 2 1 から同一な距離に位置し、維持電極 1 3 7 は外側及び内側副画素電極 1 9 0 a、1 9 0 b 全ての下方向へのびている。結合電極 1 7 6 は維持電極 1 3 7 と完全に重畳し、ドレイン電極 1 7 5 と物理的に分離されている。ドレイン電極 1 7 5 は維持電極線 1 3 1 と重畳する拡張部を有しない。

【0075】

また、データ線 1 7 1 と同一層の結合電極 1 7 6 維持電極 1 3 7 と重畳してゲート絶縁膜 1 4 0 を介在してストレージキャパシタ (Cst、図 5 参照) を構成し、結合電極 1 7 6 はドレイン電極 1 7 5 から分離されているが、連結されることもできる。この時、結合電極 1 7 6 は維持電極 1 3 7 と重なるように配置して画素の開口率が減少することを防止することができ、維持電極 1 3 7 の境界は結合電極 1 7 6 の境界中に位置するのが好ましい。

【0076】

また、第 2 絶縁膜 1 8 0 q には結合電極 1 7 6 上に位置した開口部 1 8 8 が形成されており、第 1 絶縁膜 1 8 0 p には開口部 1 8 8 内に位置して結合電極 1 7 6 を露出する接触孔 1 8 7 が備えられている。

外側副画素電極 1 9 0 a 各々は下部分及び上部分とこれらを連結する縦部を含む。縦部は接触孔 1 8 7 を通じて結合電極 1 7 6 と連結されている突出部 1 9 1 を含む。

【0077】

10

20

30

40

50

内側副画素電極 190b は開口部 188 内で保護膜 180 の第 2 絶縁膜 180p だけを間に置いて結合電極 176 と重畳して容量電極がなくても維持容量を増やすことができる。

図 1 乃至図 4 に示す液晶表示装置の多くの特徴が図 12 乃至図 15 に示す液晶表示装置にも適用できる。

【0078】

以下、図 12 乃至図 15 に示す液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施形態によって製造する方法について、図 16A 乃至図 21 及び図 12、図 14 及び図 15 を参考にして詳細に説明する。

図 16A、図 17A、図 18A 及び図 20A は、図 12 乃至図 15 に示す液晶表示装置の薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施形態によって製造する方法の中間段階での配置図であって、その順序によって羅列した図面である。図 16B は図 16A に示す薄膜トランジスタ表示板を X V I b - X V I b ' 線に沿って切断した断面図であり、図 17B は図 17A に示す薄膜トランジスタ表示板を X V I I b - X V I I b ' 線に沿って切断した断面図であり、図 18B は図 18A に示す薄膜トランジスタ表示板を X V I I I b - X V I I I b ' 線に沿って切断した断面図である。図 19 は図 18A に示す薄膜トランジスタ表示板を X V I I I b - X V I I I b ' 線に沿って切断した断面図であって、図 18B の次の段階を示した図面である。図 20B は図 20A に示す薄膜トランジスタ表示板を X X b - X X b ' 線に沿って切断した断面図であって、図 19 の次の段階を示した図面である。図 21 は図 20A に示す薄膜トランジスタ表示板を X X b - X X b ' 線に沿って切断した断面図であって、図 20B の次の段階を示した図面である。

【0079】

まず、透明なガラスなどで作られた絶縁基板 110 上に二つの層の金属膜をスパッタリングなどで順次に積層する。この時、金属膜は I Z O または I T O との接触特性に優れた金属、例えば、モリブデン、モリブデン合金またはクロムなどの下部膜と、アルミニウム系列金属からなる上部膜とで積層することができる。

次に、図 16A 及び図 16B に示すように、感光膜パターンを利用した写真エッチング工程で金属膜をパターニングして複数のゲート電極 124 を含むゲート線 121 と、複数の維持電極 137 を含む維持電極線 131 とを形成する。

【0080】

図 17A 及び図 17B に示すように、ゲート絶縁膜 140、真性非晶質シリコン層、不純物添加非晶質シリコン層の 3 層膜を連続して積層する。次に、不純物添加非晶質シリコン層及び真性非晶質シリコン層を写真エッチングして複数の線状不純物添加半導体 164 と複数の突出部 154 をそれぞれ含む線状真性半導体 151 を形成する。ゲート絶縁膜 140 の材料としては、窒化ケイ素が良く、積層温度は 250 ~ 500、厚さは 2、000 ~ 5、000 程度であるのが好ましい。

【0081】

次に、前述した導電物質をスパッタリングなどで順次に積層して金属膜を形成した後、図 18A 及び図 18B に示すように、金属膜を順次にパターニングして複数の結合電極 176 と複数のソース電極 173 をそれぞれ含む複数のデータ線 171 及び複数のドレイン電極 175 を形成する。

次に、データ線 171 及びドレイン電極 175 上部の感光膜を除去するか、又はそのまま置いた状態で、データ導電体 171、175 で覆われず露出された不純物添加半導体 164 の一部を除去することにより、複数の突出部 163 をそれぞれ含む複数の線状抵抗性接触部材 161 と複数の島状抵抗性接触部材 165 を完成する一方、その下の真性半導体 151 部分を露出させる。

【0082】

次に、真性半導体 151 部分の表面を安定化させるために、酸素プラズマを引き続いて実施するのが好ましい。

次に、図 19 に示すように、窒化ケイ素のような無機絶縁膜の第 1 絶縁膜 180p と、

10

20

30

40

50

低い誘電率を有する有機絶縁膜の第2絶縁膜180qとを順次に積層して保護膜180を形成し、その上部に感光膜をスピンコーティング方法で塗布した後、マスクを利用した写真工程で感光膜パターン52、54を形成する。

【0083】

この時、現象された感光膜の厚さは位置によって異なるが、感光膜は厚さが次第に小さくなる第1乃至第3部分からなる。A領域（以下、“その他領域”とする）に位置する第1部分と、B領域（以下、“結合領域”とする）に位置する第2部分は、それぞれ図面符号52と54として示し、C領域（以下、“接触領域”とする）に位置する第3部分に対する図面符号は付与しなかったが、これは第3部分が0の厚さを有して下側の第2絶縁膜180qが露出されているためである。

10

【0084】

このように、位置によって感光膜の厚さを異ならせる方法として様々な方法があるが、露光マスクに透明領域と遮光領域だけでなく、半透明領域を設けることがその例である。半透明領域にはスリットパターン、格子パターン、または透過率若しくは厚さが中程である薄膜が備えられる。

次に、図20A及び図20Bに示すように、感光膜パターン52、54をエッチングマスクで第2絶縁膜180qと第1絶縁膜180pとを順次にエッチングしてドレイン電極175及び結合電極176を各々露出する接触孔185、186を形成する。この時、ゲート線121及びデータ線171それぞれの端部129、179を露出する接触孔181、82も共に形成する。次に、結合領域（B）に残っている第2部分54をアッシングで

20

【0085】

次に、図21に示すように、結合領域（B）で露出された第2絶縁膜180qの一部をエッチングして第2絶縁膜180qに開口部188を形成する。

この時、第2絶縁膜180qを感光性有機絶縁物質で形成する他の実施形態では、第2絶縁膜180qを感光膜パターン52、54のように形成した後、前述した順序によってエッチング工程を進行する。

【0086】

最後に、図12、図14及び図15に示すように、500乃至1、500厚さのIZOまたはITO層をスパッタリング方法で蒸着して写真エッチングして複数の画素電極190a、190b及び複数の接触補助部材81、82を形成する。IZO層を使用する場合のエッチングは $(\text{HNO}_3 / (\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6 / \text{H}_2\text{O})$ などクロム用エッチング液を使用する湿式エッチングであるのが好ましいが、このエッチング液はアルミニウムを腐蝕させないので、データ線171、ドレイン電極175、ゲート線121でアルミニウム導電膜が腐食されることを防止することができる。

30

【0087】

本発明の他の実施形態による液晶表示装置について図22及び図23を参照して詳細に説明する。

図22は本発明の他の実施形態による液晶表示装置の構造を示した配置図であり、図23は図12の液晶表示装置をX I I - X I I ' 線に沿って切断した断面図である。

40

図22及び図23に示すように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板100、共通電極表示板200、二つの表示板100、200の間に入っている液晶層3、そして表示板100、200の外側面に付着されている一対の偏光子12、22を含む。

【0088】

図22及び図23から見るように、本実施形態による液晶表示装置用表示板100、200の層状構造は大抵図12、図14及び図15に示す液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の層状構造と同一である。

薄膜トランジスタ表示板100を見れば、基板110上にゲート電極124と端部129を含む複数のゲート線121及び維持電極137を含む複数の維持電極線131が形成

50

されており、その上にゲート絶縁膜 140、突出部 154を含む複数の線状半導体 151、突出部 163を各々含む複数の線状抵抗性接触部材 161及び複数の島状抵抗性接触部材 165が順次に形成されている。抵抗性接触部材 161、165上にはソース電極 173と端部 179を含む複数のデータ線 171、複数のドレイン電極 175及び複数の結合電極 176が形成されており、その上に第1絶縁膜 180pと第2絶縁膜 180qを含む保護膜 180が形成されている。保護膜 180及びゲート絶縁膜 140には複数の接触孔 181が形成されており、第1及び第2絶縁膜 180p、180qには複数の接触孔 182、185が形成されており、第1絶縁膜 180pには複数の接触孔 187が形成されており、第2絶縁膜 180qには複数の開口部 188が形成されている。保護膜 180上には副画素電極 190a、190bを含んで切開部 91-92bを有する複数の画素電極 190と複数の接触補助部材 81、82が形成されており、その上には配向膜 11が形成されている。

【0089】

共通電極表示板 200について説明すれば、絶縁基板 210上に遮光部材 220、複数のカラーフィルター 230、蓋膜 250、切開部 71-72bを有する共通電極、そして配向膜 21が形成されている。

しかし、図12、図14及び図15に示す液晶表示装置と違って、半導体 151はデータ線 171、ドレイン電極 175及びその下部の抵抗性接触部材 161、165と実質的に同一な平面形態を有している。しかし、線状半導体 151はソース電極 173とドレイン電極 175との間などデータ線 171及びドレイン電極 175で覆われず露出された部分を有している。

【0090】

また、結合電極 176下には複数の島状半導体 176と複数の島状抵抗性接触部材 166が形成されている。

このような薄膜トランジスタ表示板 100を本発明の一実施形態によって製造する方法では、データ線 171、ドレイン電極 175及び結合電極 176と半導体 151及び抵抗性接触部材 161、165を一回の写真工程で形成する。

【0091】

図12乃至図15に示す液晶表示装置の多くの特徴が図22及び図23に示す液晶表示装置にも適用できる。

本発明の他の実施形態による液晶表示装置について図24、図25及び図26を参照して詳細に説明する。

図24は本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の構造を示す配置図であり、図25は図24の薄膜トランジスタ表示板を含む液晶表示装置の配置図であり、図26は図25のXXVI-XXVI'線に沿って切断した断面図である。

【0092】

図24乃至図26から判るように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板 100、共通電極表示板 200、二つの表示板 100、200の間に入っている液晶層 3、そして表示板 100、200の外側面に付着されている一対の偏光子 12、22を含む。

本実施形態による液晶表示装置用表示板 100、200の層状構造は、大抵図1乃至図4に示す液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の層状構造と同一である。

【0093】

薄膜トランジスタ表示板 100を見れば、基板 110上にゲート電極 124と端部 129を含む複数のゲート線 121、維持電極 137を含む複数の維持電極線 131及び複数の容量電極 136が形成されており、その上にゲート絶縁膜 140、突出部 154を含む複数の線状半導体 151、突出部 163を各々含む複数の線状抵抗性接触部材 161及び複数の島状抵抗性接触部材 165が順次に形成されている。抵抗性接触部材 161、165及びゲート絶縁膜 140上にはソース電極 173と端部 179を含む複数のデータ線 171、拡張部 177と結合電極 176を含む複数のドレイン電極 175が形成されており

、その上に第1絶縁膜180pと第2絶縁膜180qを含む保護膜180が形成されている。保護膜180及び/またはゲート絶縁膜140には複数の接触孔181、182、186が形成されている。保護膜180上には副画素電極190a、190bを含んで切開部91-92を有する複数の画素電極190と複数の接触補助部材81、82が形成されており、その上には配向膜11が形成されている。

【0094】

共通電極表示板200について説明すれば、絶縁基板210上に遮光部材220、複数のカラーフィルタ230、蓋膜250、切開部71-72bを有する共通電極、そして配向膜21が形成されている。

しかし、図1乃至図4の液晶表示装置と違って、本実施形態による薄膜トランジスタ表示板には、外側副画素電極190aが下部190a1及び上部190a2（今後、下部及び上部副画素電極という）の二つの部分に分れている。つまり、各切開部92が画素電極190を真っすぐ貫通する二つの斜線部92a、92bを含む。したがって、切開部92には縦部がなく、外側副画素電極190aにも縦連結部がない。

10

【0095】

したがって、内側副画素電極190bが画素電極190の左辺までのびて開口率が高くなる。

容量電極136各々は画素電極190の左辺付近に位置し、データ線171と平行にのびて下部及び上部副画素電極190a1、190a2に全てのびる。容量電極136は右側に突出した突出部139を含み、突出部139は接触孔186によって露出されて内側副画素電極190bと連結される。接触孔186は有効表示領域に相当しない切開部91と一直線上に位置するので、表示特性が良くなる。

20

【0096】

結合電極176各々は容量電極136と重畳し、突出部139を除けば容量電極136と似ている。ドレイン電極175各々は拡張部177と結合電極176を連結する連結部178をさらに含む。連結部178は切開部72aに沿ってななめにのびて切開部72aの光漏れを遮断して開口率を高める。

保護膜180は結合電極176の両端を露出する複数対の接触孔185a1、185a2を有し、下部及び上部副画素電極190a1、190a2は接触孔185a1、185a2を通じて結合電極176と連結されている。

30

【0097】

実質的に、このような構造は図1乃至図4の構造と比較して4-5%程度に開口率が向上すると測定された。

図1乃至図4に示す液晶表示装置の多くの特徴が図24乃至図26に示す液晶表示装置にも適用できる。

次に、図28及び図29を参照して本発明の他の実施形態による液晶表示装置について詳細に説明する。

【0098】

図27は本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の構造を示した配置図であり、図28は図27の薄膜トランジスタ表示板を含む液晶表示装置の配置図であり、図29は図28の液晶表示装置をXXIX-XXIX'線に沿って切断した断面図である。

40

図27乃至図29に示すように、本実施形態による液晶表示装置もまた薄膜トランジスタ表示板100、共通電極表示板200、二つの表示板100、200の間に入っている液晶層3、そして表示板100、200の外側面に付着されている一対の偏光子12、22を含む。

【0099】

本実施形態による液晶表示装置用表示板100、200の層状構造は、大抵図12、図14及び図15に示す液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の層状構造と同一である。

薄膜トランジスタ表示板100を見れば、基板110上にゲート電極124と端部129を含む複数のゲート線121及び維持電極137を含む複数の維持電極線131が形成

50

されており、その上にゲート絶縁膜 140、突出部 154を含む複数の線状半導体 151、突出部 163を各々含む複数の線状抵抗性接触部材 161及び複数の島状抵抗性接触部材 165が順次に形成されている。抵抗性接触部材 161、165及びゲート絶縁膜 140上にはソース電極 173と端部 179を含む複数のデータ線 171、複数のドレイン電極 175及び複数の結合電極 176が形成されており、その上に第1絶縁膜 180pと第2絶縁膜 180qを含む保護膜 180が形成されている。保護膜 180及びゲート絶縁膜 140には複数の接触孔 181が形成されており、第1及び第2絶縁膜 180p、180qには複数の接触孔 182が形成されており、第2絶縁膜 180qには複数の開口部 188が形成されている。保護膜 180上には副画素電極 190a、190bを含んで切開部 91-92bを有する複数の画素電極 190と複数の接触補助部材 81、82が形成されており、その上には配向膜 11が形成されている。 10

【0100】

共通電極表示板 200について説明すれば、絶縁基板 210上に遮光部材 220、複数のカラーフィルター 230、蓋膜 250、切開部 71-72bを有する共通電極、そして配向膜 21が形成されている。

しかし、図12、図14及び図15の薄膜トランジスタ表示板と違い、本実施形態による薄膜トランジスタ表示板では、外側画素電極 190aが下部 190a1及び上部 190a2（今後、下部及び上部副画素電極という）の二つの部分に分れている。つまり、各切開部 92が画素電極 190を真っすぐ貫通する二つの斜線部 92a、92bを含む。したがって切開部 92には縦部がなく、外側画素電極 190aにも縦連結部がない。 20

【0101】

したがって、内側副画素電極 190bが画素電極 190の左辺までのびて開口率が高くなる。

各ドレイン電極 175はまた、結合電極 176をドレイン電極 175に連結する下部連結部 178a1と、結合電極 176から上部副画素電極 190a2までのびた上部連結部 178a2を含む。下部連結部 178a1は切開部 72aに沿ってななめにのびて切開部 72aの光漏れを遮断して開口率を高めて、再び上に方向を変えて結合電極 176に連結される。

【0102】

下部連結部 178a1を露出する接触孔 185a1が連結部 178a1の転換点に備えられており、上部連結部 178a2を露出する他の接触孔 185a2が上部連結部 178a2の上端に備えられている。下部及び上部副画素電極 190a1、190a2は接触孔 185a1、185a2を通じて下部及び上部連結部 178a1、178a2に各々連結されている。 30

【0103】

実質的に、このような構造は図12乃至図15の構造と比較して2-4%程度に開口率が向上すると測定された。

図12乃至図15に示す液晶表示装置の多くの特徴が図27乃至図29に示す液晶表示装置にも適用できる。

本実施形態は挟まれたネマチック方式（TN）液晶表示装置や平面駆動方式（IPS）液晶表示装置にも適用できる。 40

【0104】

以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されず、請求範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者による様々な変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属するものである。特に、画素電極と共通電極に形成する切開部の配置は多様な変形があり得る。

本発明によれば、画素電極を分割して互いに異なる電圧を印加をすることによって液晶表示装置の側面視認性を向上させ、これによって視野角を拡張することができる。

【0105】

また、維持容量を形成する時、ゲート絶縁膜だけを介在させて維持電極と結合電極を重 50

畳させ、結合容量を形成する時、保護膜の一部だけを介在させて副画素電極と結合電極を重畳させ、重畳面積を狭くしても維持容量と結合容量を十分に確保することによって画素の開口率を確保することができる。

また、切開部を延長させて副画素電極を拡張させ、ドレイン電極と結合電極との連結部分を画像が表示されない切開部と重畳配置することにより、画素の開口率を向上させることができる。接触孔によって発生するテクスチャーを画像が表示される領域の外部に誘導することによって表示特性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【0106】

【図1】本発明の一実施形態による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図である。 10

【図2】本発明の一実施形態による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図である。

【図3】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。

【図4】図3の液晶表示装置をI V - I V ' 線に沿って切断した断面図である。

【図5】図1乃至図4に示す液晶表示装置の等価回路図である。

【図6】本発明の他の実施形態による液晶表示装置の構造を示した配置図である。

【図7】図6の液晶表示装置をV I I - V I I ' 線に沿って切断した断面図である。

【図8】本発明の他の実施形態による液晶表示装置の配置図である。

【図9】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。

【図10】本発明の他の実施形態による共通電極の配置図である。 20

【図11】図9及び図10の二つの表示板を含む液晶表示装置の配置図である。

【図12】本発明の他の実施形態による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図である。

【図13】本発明の他の実施形態による液晶表示装置用共通電極表示板の配置図である。

【図14】図12の薄膜トランジスタ表示板と図13の共通電極表示板を含む液晶表示装置の配置図である。

【図15】図14の液晶表示装置をX V - X V ' 線に沿って切断した断面図である。

【図16A】図12乃至図15に示す液晶表示装置の薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施形態によって製造する方法の中間段階での配置図であって、その順序によって羅列した図面である。 30

【図16B】図16Aに示す薄膜トランジスタ表示板をX V I b - X V I b ' 線に沿って切断した断面図である。

【図17A】図12乃至図15に示す液晶表示装置の薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施形態によって製造する方法の中間段階での配置図であって、その順序によって羅列した図面である。

【図17B】図17Aに示す薄膜トランジスタ表示板をX V I I b - X V I I b ' 線に沿って切断した断面図である。

【図18A】図12乃至図15に示す液晶表示装置の薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施形態によって製造する方法の中間段階での配置図であって、その順序によって羅列した図面である。 40

【図18B】図18Aに示す薄膜トランジスタ表示板をX V I I I b - X V I I I b ' 線に沿って切断した断面図である。

【図19】図18Aに示す薄膜トランジスタ表示板をX V I I I b - X V I I I b ' 線に沿って切断した断面図であって、図18Bの次の段階を示した図面である。

【図20A】図12乃至図15に示す液晶表示装置の薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施形態によって製造する方法の中間段階での配置図であって、その順序によって羅列した図面である。

【図20B】図20Aに示す薄膜トランジスタ表示板をX X b - X X b ' 線に沿って切断した断面図であって、図19の次の段階を示した図面である。

【図21】図20Aに示す薄膜トランジスタ表示板をX X b - X X b ' 線に沿って切断し 50

た断面図であって、図 20 の次の段階を示した図面である。

【図 22】本発明の他の実施形態による液晶表示装置の構造を示した配置図である。

【図 23】図 22 の液晶表示装置を X I I - X I I ' 線に沿って切断した断面図である。

【図 24】本発明のまた他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の構造を示した配置図である。

【図 25】図 24 の薄膜トランジスタ表示板を含む液晶表示装置の配置図である。

【図 26】図 25 の X X V I - X X V I ' 線に沿って切断した断面図である。

【図 27】本発明のまた他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の構造を示した配置図である。

【図 28】図 27 の薄膜トランジスタ表示板を含む液晶表示装置の配置図である。

10

【図 29】図 28 の液晶表示装置を X X I X - X X I X ' 線に沿って切断した断面図である。

【符号の説明】

【0107】

121 ゲート線

124 ゲート電極

131、137 維持電極

151、154 半導体

161、163、165 抵抗性接触部材

171 データ線

173 ソース電極

175 ドレイン電極

176 結合電極

181、182、185、186 接触孔

1851、1852 接触孔

190 画素電極

191、192、193 切開部

270 対向電極

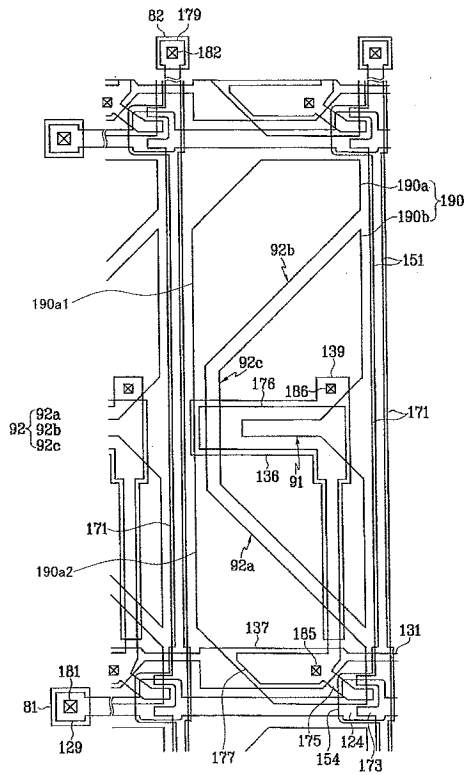
271、272、273 切開部

180p、180q 第1、第2絶縁膜

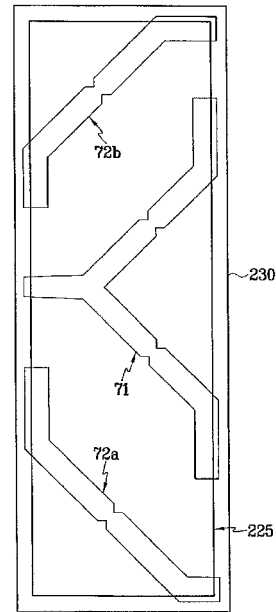
20

30

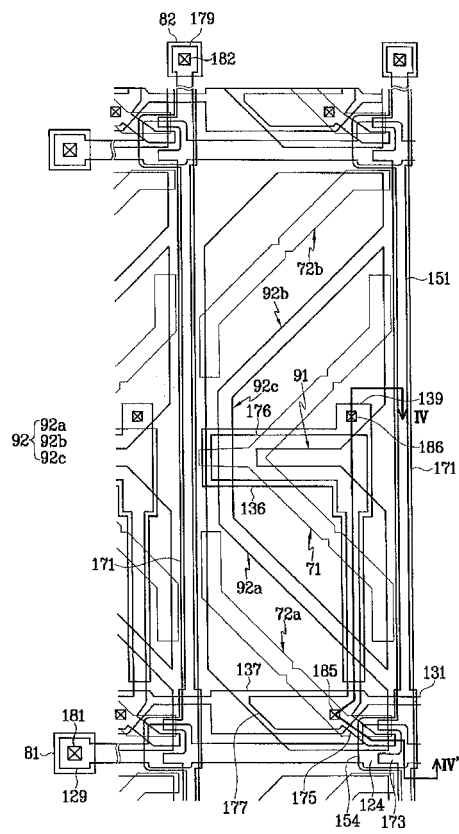
【図 1】



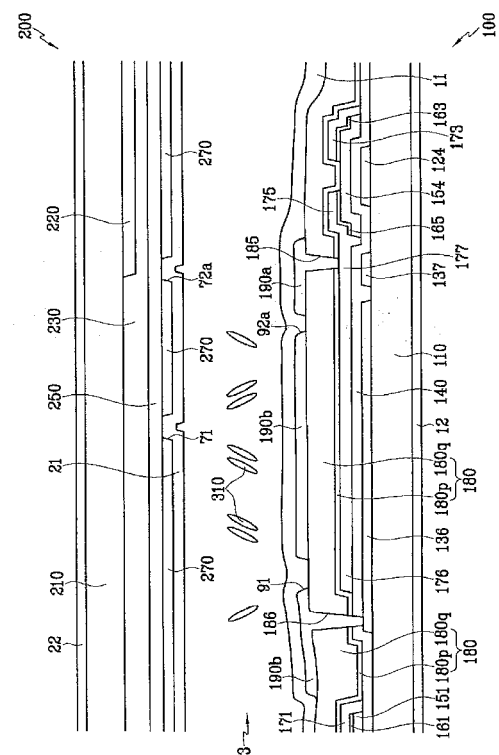
【図 2】



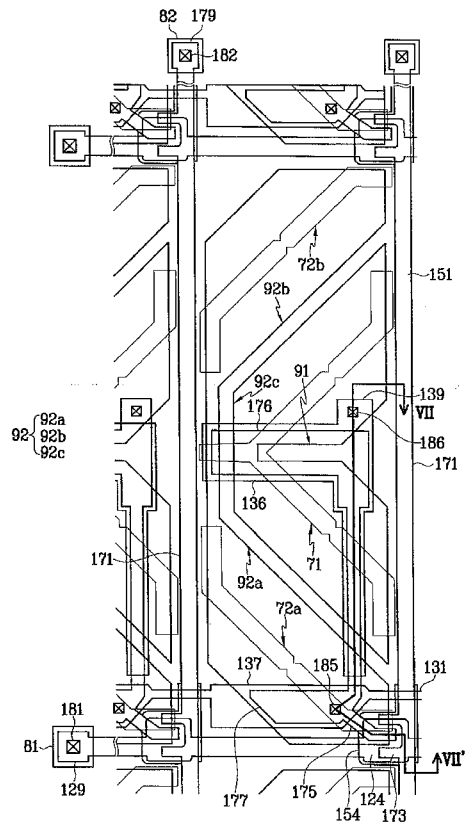
【図 3】



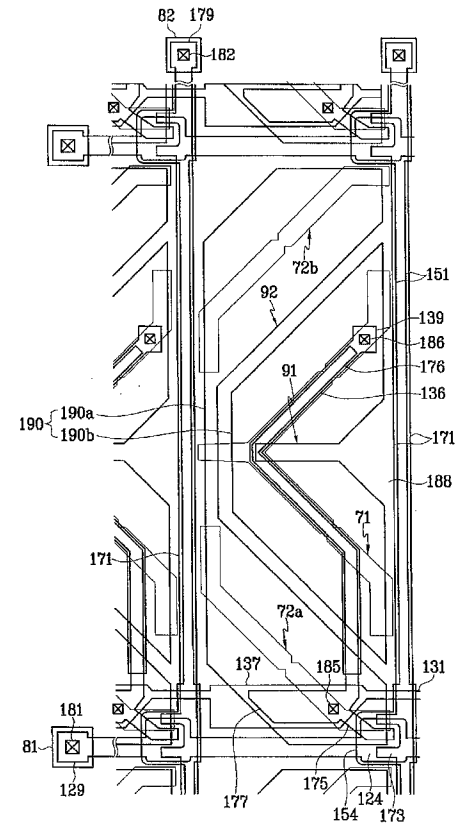
【図 4】



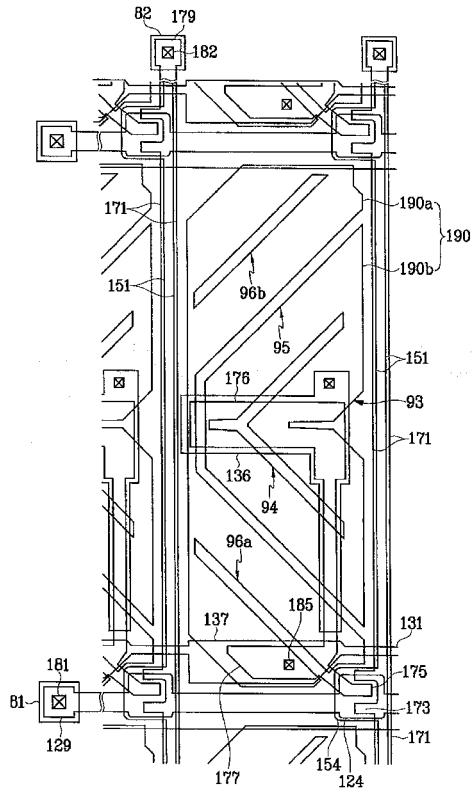
【 図 6 】



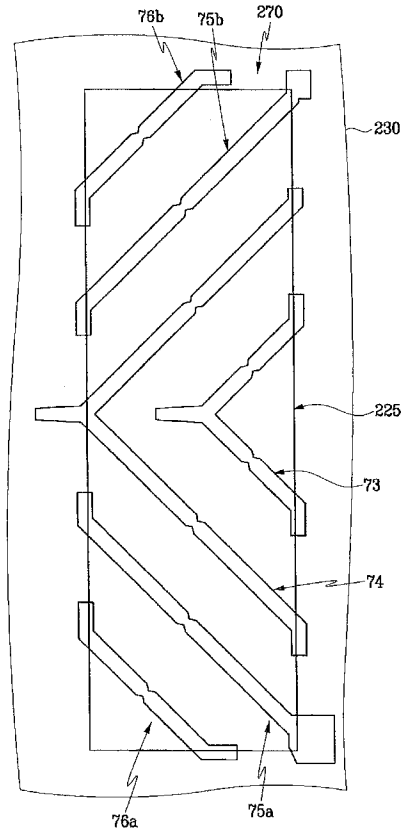
【 図 8 】



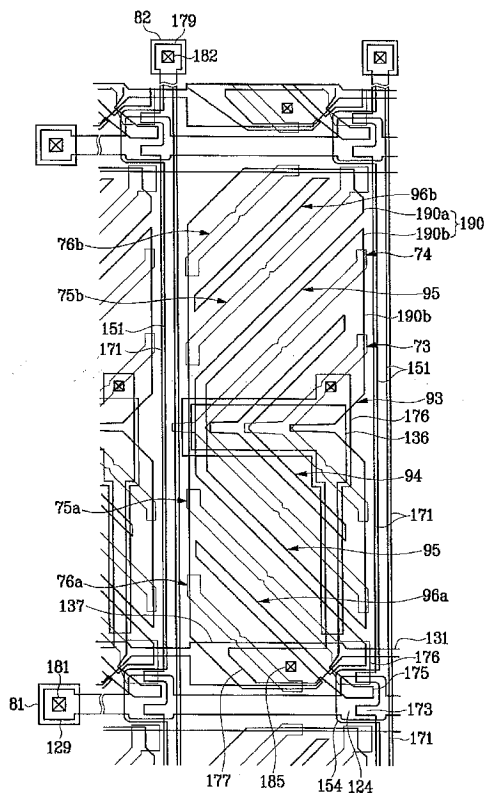
【図 9】



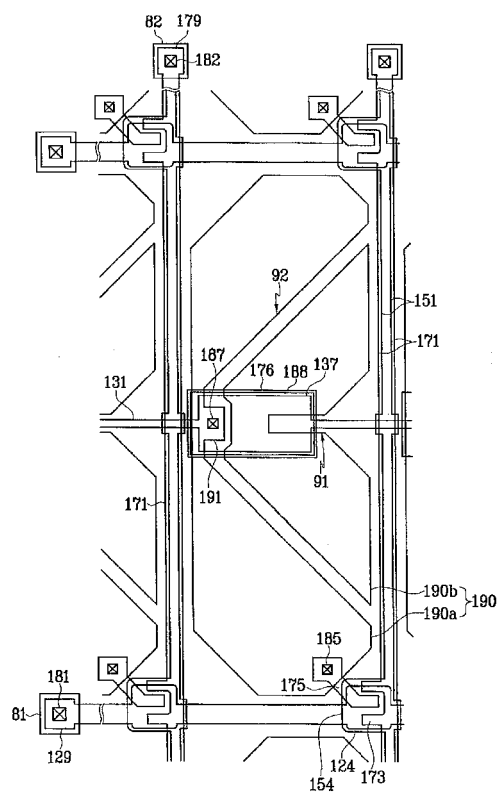
【図 10】



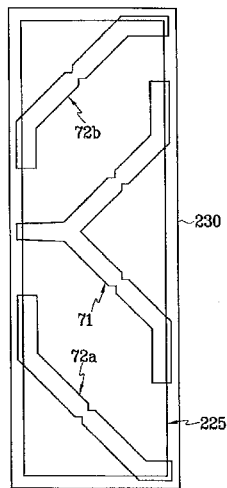
【図 11】



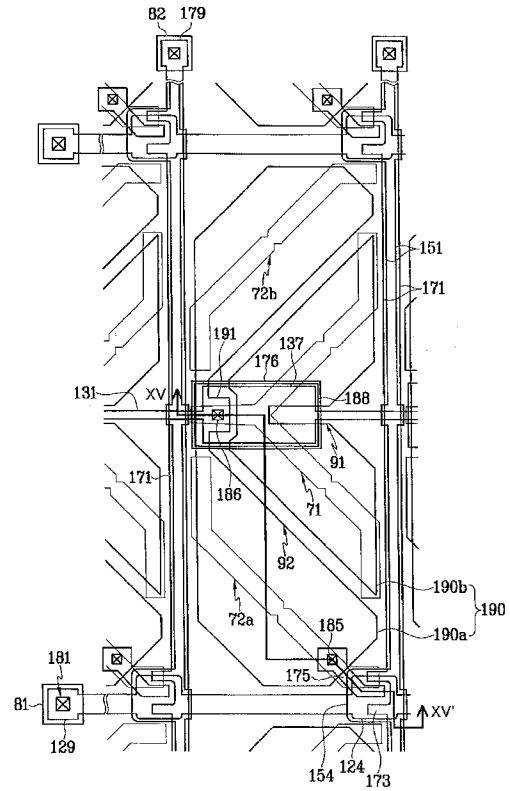
【図 12】



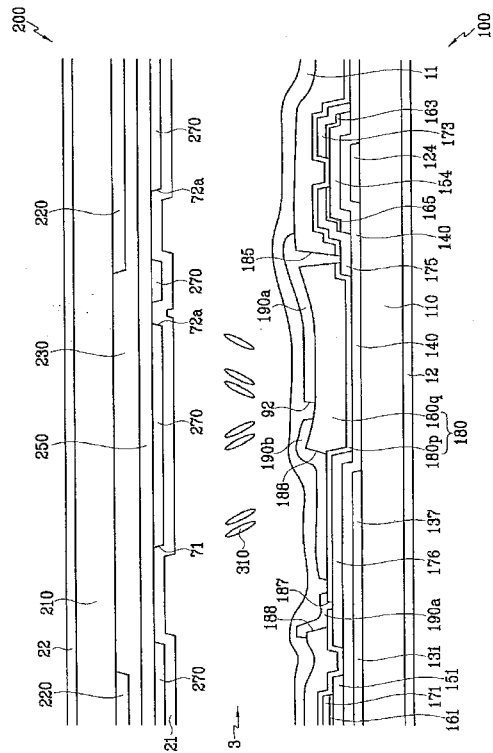
【図 13】



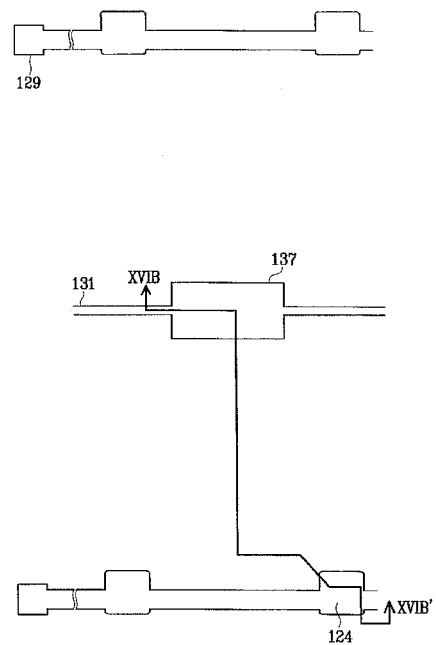
【図 14】



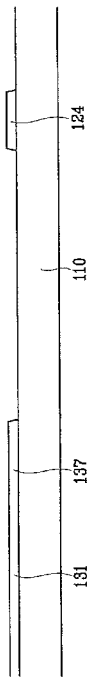
【図 15】



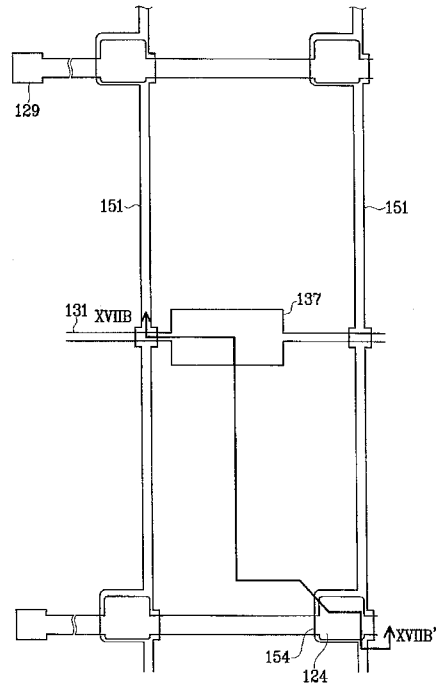
【図 16 A】



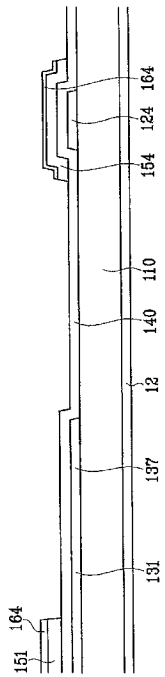
【図 16 B】



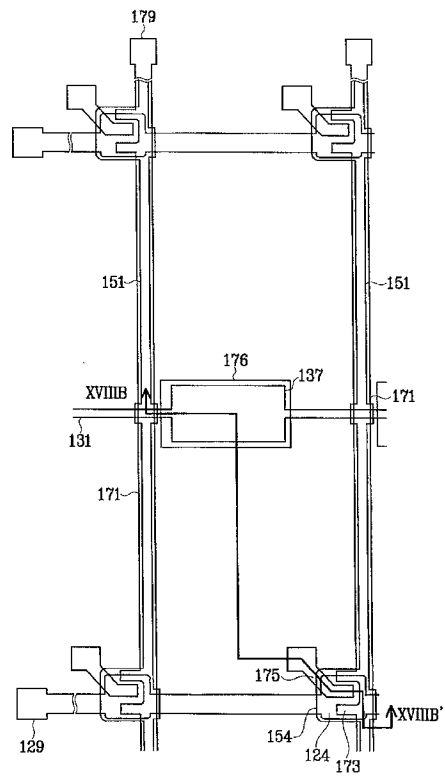
【図 17 A】



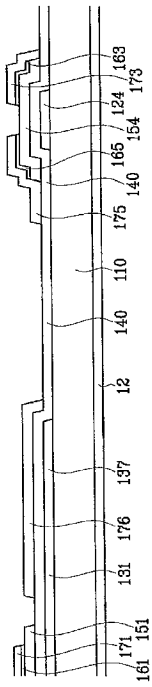
【図 17 B】



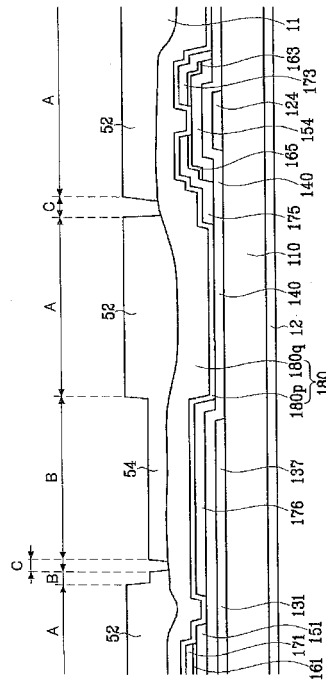
【図 18 A】



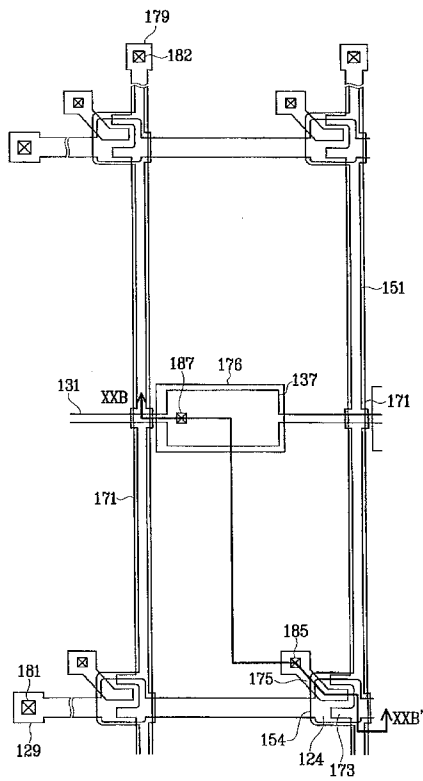
【図 18 B】



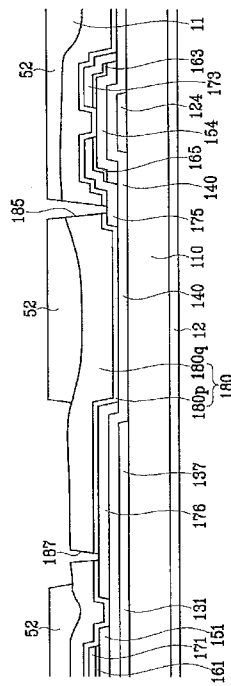
【図 19】



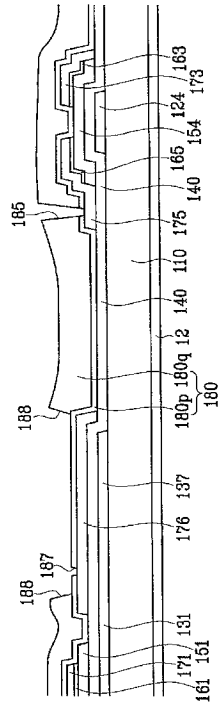
【図 20 A】



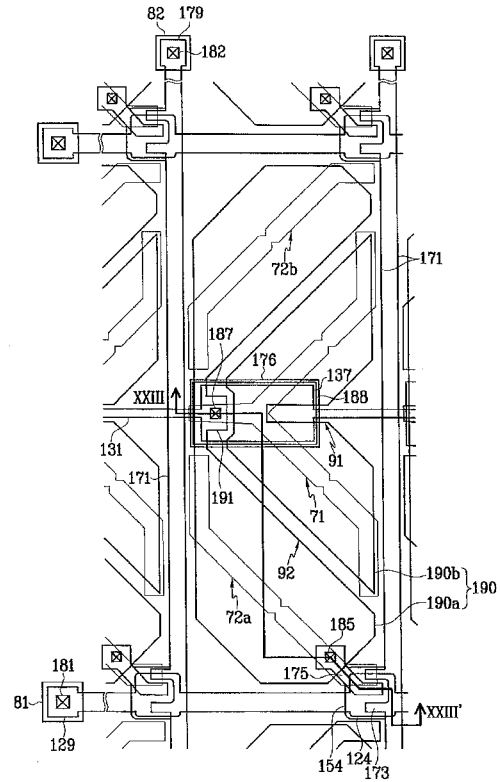
【図 20 B】



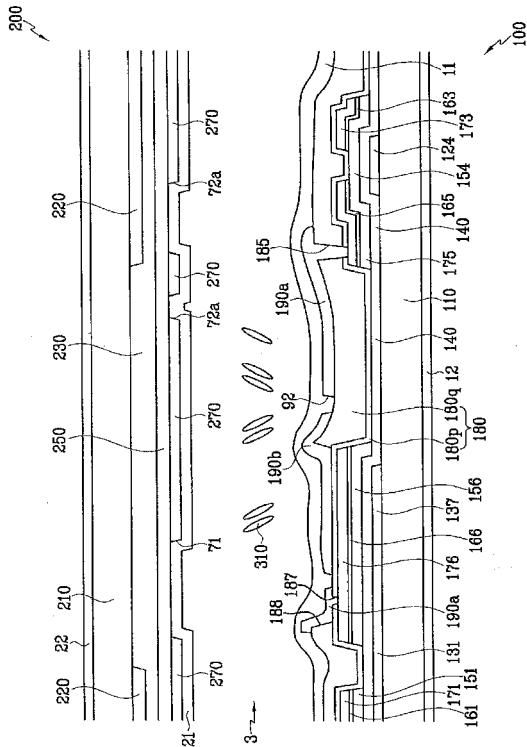
【図 2 1】



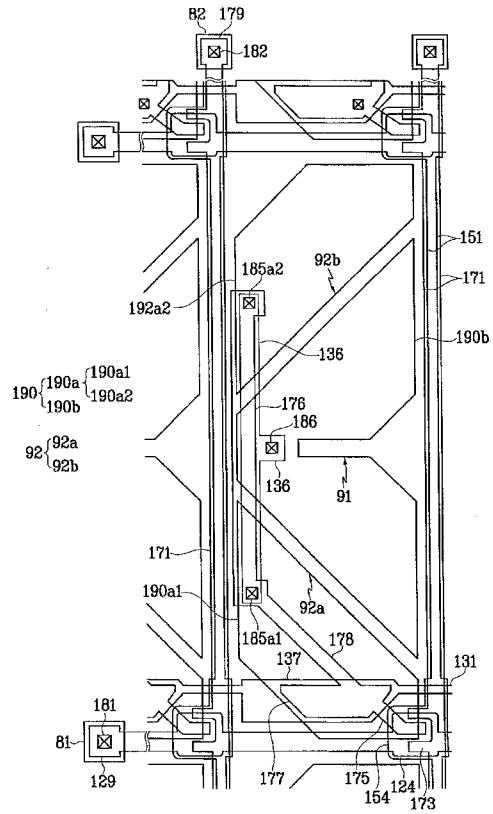
【図 2 2】



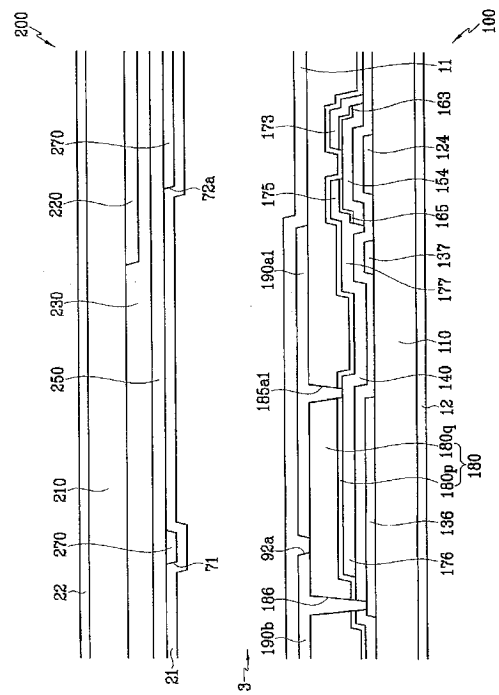
【図 2 3】



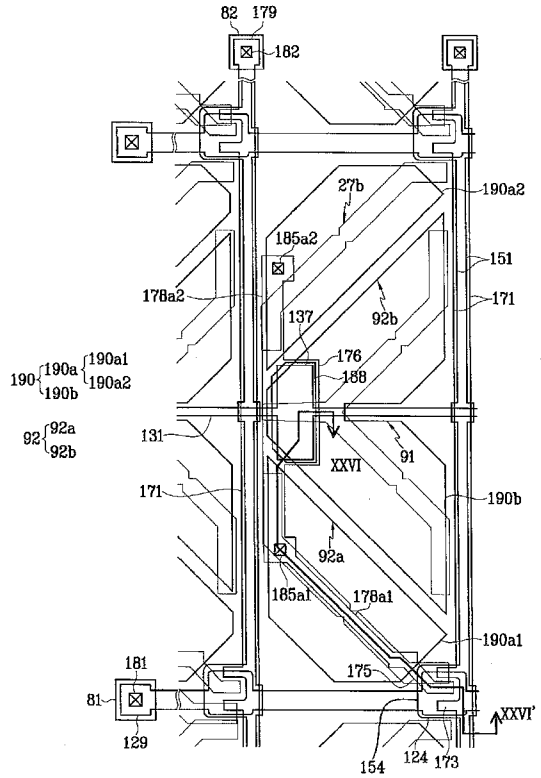
【図 2 4】



【 図 2 6 】



【 図 2 8 】



フロントページの続き

(72)発明者 申 ▲キョン▼ 周

大韓民国京畿道龍仁市器興邑南羅里 2 8 9 - 1 2 番地サムジョンソンビマウル 1 0 2 棟 5 0 4 号

(72)発明者 蔡 鍾 哲

大韓民国ソウル市麻浦区新孔徳洞三星アパート 1 0 2 棟 2 0 0 1 号

(72)発明者 朴 哲 佑

大韓民国京畿道水原市八達区梅灘 2 洞韓国 1 次アパート 1 0 2 棟 6 0 1 号

(72)発明者 李 昶 勳

大韓民国京畿道龍仁市器興邑書川里 7 0 5 番地イエヒョンマウル現代ホームタウン 1 0 4 棟 1 2 0 5 号

F ターム(参考) 2H090 LA01 MA07 MA14

2H092 GA13 JA24 JB05 JB14 NA04

专利名称(译)	薄膜晶体管阵列面板		
公开(公告)号	JP2006039567A	公开(公告)日	2006-02-09
申请号	JP2005216211	申请日	2005-07-26
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
[标]发明人	申キヨン周 蔡鍾哲 朴哲佑 李昶勳		
发明人	申 ▲キヨン▼ 周 蔡 鍾 哲 朴 哲 佑 李 昶 勳		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1337 G02F1/1343		
CPC分类号	G02F1/136213 G02F1/133707 G02F1/134336 G02F1/1393 G02F2001/134345		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1337 G02F1/1343		
F-TERM分类号	2H090/LA01 2H090/MA07 2H090/MA14 2H092/GA13 2H092/JA24 2H092/JB05 2H092/JB14 2H092/NA04 2H092/JB45 2H192/AA24 2H192/BA25 2H192/BC23 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB46 2H192/CC12 2H192/CC42 2H192/CC52 2H192/DA12 2H192/EA04 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/FA35 2H192/GD14 2H192/JA13 2H290/AA15 2H290/AA33 2H290/AA72 2H290/BB24 2H290/BB44 2H290/BB53 2H290/BB67 2H290/BB73 2H290/BB84 2H290/CA33 2H290/CA46 2H290/CA48		
优先权	1020040058709 2004-07-27 KR		
其他公开文献	JP4791099B2 JP2006039567A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

实现了可视性优异的多域液晶显示装置。基板，形成在基板上的第一信号线，与第一信号线相交的第二信号线以及与第一信号线和第二信号线的连接。薄膜晶体管，彼此分离并连接至薄膜晶体管的第一子像素电极和第二子像素电极以及电容耦合至第一子像素电极和第二子像素电极中的至少一个的第一子像素电极和第二子像素电极。具有三个子像素电极的像素电极。[选择图]图24

